

# МОЩНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (Power MOSFET)

**HARRIS** является мировым лидером в производстве **Power MOSFET**.

Выпускаются как n-канальные, так и p-канальные транзисторы, но первые используются чаще и имеют больший диапазон токов и напряжений. Кроме этого выпускаются полевые транзисторы с управлением сигналом логического уровня, с ограничением тока, с защелкой по напряжению.

Области применения: регуляторы, конвертеры, драйверы двигателей, реле и мощных биполярных транзисторов. Полевые транзисторы имеют очень высокое входное сопротивление и обычно могут управляться непосредственно от микросхемы без дополнительных усилительных каскадов.

## Power MOSFET, серия IRF

Максим. значения							
$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$					
п-канал		р-канал					
Максим. значения							
$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	<b>TO-204</b>	<b>TO-220AB</b>	<b>TO-247</b>	<b>DIP-4</b>	
<b>п-канал</b>							
100	0,4	3,2				IRFD122	
	0,8	0,8				IRFD112	
	1,3	0,3				IRFD120	
	5,6	0,54			IRF510		
	9,2	0,27	IRF120	IRF520			
	14,0	0,16			IRF530		
	28,0	0,077	IRF140	IRF540			
200	40,0	0,055	IRF150			IRFP150	
	0,45	2,4				IRFD212	
	0,80	0,8				IRFD220	
	3,3	1,5			IRF610		
	5,0	0,8	IRF220	IRF620			
	9,0	0,4	IRF230	IRF630			
	18,0	0,18	IRF240	IRF640			
400	33,0	0,085	IRF250			IRFP250	
	0,4	3,6				IRFD310	
	2,0	3,6			IRF710		
	3,3	1,8	IRF320				
	5,5	1,0	IRF330	IRF730			
	10,0	0,55	IRF340	IRF740			
	16,0	0,3	IRF350			IRFP350	
500	23,0	0,2	IRF360			IRFP360	
	2,5	3,0	IRF420	IRF820			
	4,5	1,5	IRF430	IRF830			
	8,0	0,85	IRF440				
	14,0	0,4	IRF450			IRFP450	
	20,0	0,27	IRF460			IRFP460	
	4000	4,3	3,5				IRFPG40
<b>р-канал</b>							
100	1,0	0,6				IRFD9120	
	3,0	1,2			IRF9510		
	6,0	0,6			IRF9520		
	12,0	0,3	IRF9130	IRF9530			
	19,0	0,2	IRF9140	IRF9540	IRFP9140		
200	3,5	1,5			IRF9620		
	6,5	0,8	IRF9230	IRF9630			
	11,0	0,5	IRF9240	IRF9640			

## Mega FET серия

Максим. значения					
$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$			
п-канал		р-канал			
Максим. значения					
$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	<b>TO-220AB</b>		
<b>п-канал</b>					
50	14	0,1	RFP14N05		
	25	0,047	RFP25N05		
	50	0,22	RFP50N05		
100	22	0,080	RFP22N10		
	40	0,040	RFP40N10		
<b>р-канал</b>					
50	8	0,300	RFP8P05		
	15	0,150	RFP15P05		
	30	0,065	RFP30P05		
<b>п-канал, управление логическим уровнем</b>					
50	4	0,800	RFP4N05L		
	14	0,100	RFP14N05L		
	25	0,047	RFP25N05L		
	50	0,022	RFP50N05L		
100	2	1,050	RFP2N10L		
	7	0,300	RFP7N10LE		
	12	0,200	RFP12N10L		
200	2	3,500	RFP2N20L		
	8	0,500	RFP8N20L		
<b>р-канал, управление логическим уровнем</b>					
30	10	0,225	RFP10P03L		



Более подробную информацию можно получить по адресу [www.semi.harris.com](http://www.semi.harris.com) или заказав литературу непосредственно у **HARRIS**. Бланк для заказа литературы приведен в каталоге.

## п-канальные MOSFET, серия BUZ

Максим. значения	Максимальные значения			Максим. значения	Максимальные значения		
	$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$		$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$
50	14,0	0,1	BUZ71	200	9,5	0,4	BUZ32
	30,0	0,04	BUZ11	400	3,0	1,8	BUZ76
	9,0	0,25	BUZ72A		5,5	1,0	BUZ60
100	19,0	0,1	BUZ21	500	4,0	2,0	BUZ42
	200	5,8	0,6	BUZ73A	1000	4,3	3,5

## Улучшенные Power MOSFET

Максим. значения			
$V_{си, В}$	$I_{си(огр.), А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	
80	1	0,75	<b>TO-220AB</b> RLP1N08LE
	5,5	0,12	RLP5N08LE

### RLP1N08LE, RLP5N08LE

Имеют встроенную схему, ограничивающую max значения  $I_{си}$  на уровне 1 А и 5,5 А соответственно. Встроенный стабилизатор защищает от статического электричества до 2 кВ.

Максим. значения			
$V_{си, В}$	$I_{си(огр.), А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	
55	1	0,75	<b>TO-220AB</b> RLP1N06CLE

### RLP1N06CLE

Имеют схему ограничения  $I_{си}$ , защелку по напряжению (уровень 60÷70 В), встроенный стабилизатор для защиты от статического электричества до 2 кВ.